

Список публикаций по теме диссертации ведущей организации
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем
технологии микроэлектроники и особых чистых материалов Российской академии наук
(ИПТМ РАН)

1. A. Y. Polyakov, V. I. Nikolaev, S. I. Stepanov, A. I. Pechnikov, E. B. Yakimov, N.B. Smirnov, I. V. Shchemerov, A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, A.V. Chernykh, S. J. Pearton, "Electrical Properties and Deep Traps in α -Ga₂O₃:Sn Films Grown on Sapphire by Halide Vapor Phase Epitaxy", ECS Journal of Solid State Science and Technology, V9, N, с.045003, 2020г.
2. T.M. Vincent, S.K. Estreicher, J. Weber, V. Kolkovsky, N. Yarykin, "The Cu photoluminescence defect and the early stages of Cu precipitation in Si", J Applied Physics, V127, N, с.085704, 2020г.
3. O.A. Soltanovich, V.I. Orlov, N. Yarykin, E.B. Yakimov, "Room-Temperature Ni Interaction with Deformation-Induced Defects in Si: A DLTS Study", Physica Status Solidi A, V216, N17, с.1900326, 2019г.
4. P. S. Vergeles, V. I. Orlov, A. Y. Polyakov, E.B. Yakimov, Taehwan Kim, In-Hwan Lee, "Recombination and optical properties of dislocations gliding at room temperature in GaN under applied stress", Journal of Alloys and Compounds, V776, N, с.181, 2019г.
5. С.М. Пещерова, Е.Б. Якимов, А.И. Непомнящих, В.И. Орлов, О.В. Феклисова, Л.А. Павлова, Р.В. Пресняков, "Зависимость объемных электрофизических свойств мультикремния от параметров разориентации зерен", Физика и Техника Полупроводников, V53, N1, с.59, 2019г.
6. В.И. Орлов, Н.А. Ярыкин, Е.Б. Якимов, "Влияние никеля и меди, введенных при комнатной температуре, на рекомбинационные свойства протяженных дефектов в кремнии", Физика и Техника Полупроводников, V53, N4, с.433, 2019г.
7. N. Yarykin, J. Weber, "Electrically Active Copper–Nickel Complexes in p-Type Silicon", Physica Status Solidi A, V, N, с.1900304, 2019г.
8. Н.А. Ярыкин, В.Б. Шуман, Л.М. Порцель, А.Н. Лодыгин, Ю.А. Астров, Н.В. Абросимов, J. Weber, "Исследование энергетического спектра кристаллов Si : Mg методом DLTS", Физика и Техника Полупроводников, V53, N6, с.799, 2019г.
9. A.Y. Polyakov, Jin-Hyeon Yun, A.S. Usikov, E.B. Yakimov, N.B. Smirnov, K.D. Shcherbachev, H. Helava, Y.N. Makarov, S.Y. Kurin, N.M. Shmidt, O.I. Rabinovich, S.I. Didenko, S.A. Tarelkin, B.P. Papchenko, In-Hwan Lee, "Structural, electrical and luminescent characteristics of ultraviolet light emitting structures grown by hydride vapor phase epitaxy", Modern Electronic Materials, V3, N, с.32, 2017г.